Спектры отражения двух полиморфных модификаций арсенида кадмия

© А.И. Козлов[¶], В.В. Соболев^{*¶¶}, А.Ф. Князев^{+¶¶¶}

Международная лаборатория сверхпроводимости и твердотельной электроники Академии наук Республики Молдова, МД 2028 Кишинев, Молдова * Удмуртский государственный университет, 426034 Ижевск, Россия * Курский государственный университет, 305000 Курск, Россия

(Получена 14 октября 2003 г. Принята к печати 19 мая 2004 г.)

Представлены новые результаты исследования оптических свойств арсенида кадмия. Наиболее достоверные спектры отражения со сложной поляризованной структурой были получены благодаря использованию совершенных кристаллов и прецизионной спектральной техники. Спектры отражения полиморфных модификаций α'' -Cd₃As₂ (пространственная группа D_{4h}^{15}) и α' -Cd₃As₂ (пространственная группа D_{4h}^{11}) измерены при комнатной температуре и температуре жидкого азота в поляризованном свете ($\mathbf{E} \perp \mathbf{c}, \mathbf{E} \parallel \mathbf{c}$) в интервале энергий падающего света 1–5 эВ. Впервые обнаружена анизотропия спектров отражения для α' -модификации. Проведено сравнение полученных данных с известными экспериментальными и теоретическими результатами.

Соединения типа $A_3^{II}B_2^V$ образованы по правилам формальной валентности и являются тетраэдрическими фазами. Особенности физических свойств этих полупроводиков обусловлены наличием структурных вакансий атомов металла и смещением атомов по направлению к соседним вакансиям. Cd_3As_2 — весьма интересное соединение, имеющее очень маленькую величину запрещенной зоны E_g и высокую подвижность [1,2].

Арсенид кадмия имеет пять полиморфных модификаций с большим количеством атомов в элементарной ячейке [3]. Постоянные решетки приведены в [4–6]. Простой механизм перестройки структур при полиморфизме дан в [7]. Следует отметить, что в работах, посвященных оптическим свойствам Cd_3As_2 , обычно нет точных указаний на кристаллическую структуру. Это может являться одной из причин, порождающих противоречия между данными разных авторов.

Теоретико-групповые расчеты зон кристаллов Cd₃As₂ (α -модификация) выполнены в [8]. В работе [9] зонная структура Cd₃As₂ рассчитана методом псевдопотенциала, причем вместо реальной решетки использовалась решетка гипотетического кристалла со структурой флюорита. Авторы [10] выполнили расчеты для реальной симметрии. Потенциалы Cd и As взяты из данных для CdTe и GaAs. Матричные элементы конструировались, как в [8]. В [11] расчеты структуры зон проводились \mathbf{k} -**p**-методом вблизи точки Г. Предполагалось, что $E_g = -0.095$ эВ. Для интерпретации результатов магнетооптических измерений системы Cd–As–Zn авторы [12] также считали, что арсенид кадмия обладает инверсной зонной структурой типа HgTe. В [13] предложена эмпирическая модель зонной структуры Cd₃As₂

с $E_g = -0.19$ эВ. В [3] доказательства такой модели считаются неубедительными.

Спектры отражения в инфракрасной области были измерены только для твердых растворов системы Cd-As-Zn [14]. В работе [15] были исследованы спектры отражения поликристаллических образцов Cd₃As₂ при комнатной температуре и обнаружено 2-3-широких максимума. В [16] изучены спектры отражения монокристаллов Cd₃As₂ при 77 и 293 K, в которых в области 1-5 эВ проявляются 5-7 структур. В [17] приводятся спектры отражения более совершенных кристаллов Cd₃As₂ в поляризованном свете (при 293 K) и расчеты оптических функций $n, k, \varepsilon_1, \varepsilon_2$. Для результатов работ [15-17] характерно сильное падение величины коэффициента отражения *R* в области энергий hv > 3 эВ. Спектры термоотражения при 293 К исследованы в [18,19]. Ряд пиков хорошо коррелирует с данными по отражению, а три самые длинноволновые структуры в отражении не проявляются. В области вакуумного ультрафиолета спектры отражения Cd₃As₂ изучены в [20], где также приведены результаты расчета оптических функций в области 0-20 эВ при комнатной температуре. Спектры отражения и некоторые оптические функции твердого раствора Cd_{2.1}Zn_{0.9}As₂ приведены в [21].

Мы исследовали спектры отражения Cd_3As_2 в области 1-5 эВ в поляризованном свете ($\mathbf{E} \perp \mathbf{c}, \mathbf{E} \parallel \mathbf{c}$) на установке с использованием монохроматора ДФС-12 [22]. В установке применялся отсчетный метод измерений (метод электрической компенсации). Сущность метода заключается в оптическом и электрическом разделении сигналов, соответствующих падающему и отраженному от исследуемого объекта пучков света, обработке их и сравнении для получения абсолютного значения коэффициента зеркального отражения. Перед входной щелью монохроматора располагался светофильтр. Поляризация

[¶] E-mail: kozlov@lises.asm.md

^{¶¶} E-mail: sobolev@uni.udm.ru

^{¶¶¶} E-mail: tol47@kursknet.ru



Рис. 1. Спектры отражения монокристалла α'' -Cd₃As₂ при 293 K (*1*) и 80 K (*2*).

света осуществлялась призмой Глана-Томсона. С помощью светоделительного устройства свет разделялся на два одинаковых по интенсивности канала. В канале измерения помещался криостат с исследуемым образцом. Канал сравнения служил для измерения интенсивности падающего на образец света. Для компенсации оптической среды (окна криостата) служила кварцевая пластина. Угол падения света отличался от нормального на 6°. Для предотвращения поступления в криостат легких фракций масел были предусмотрены 3 азотные ловушки. Кроме того, перед заливкой жидкого азота криостат отключался от вакуумной системы для исключения осаждения масляной пленки. Крепление образца осуществлялось на гранях медного стакана с помощью специального сплава ($T_m = 30 - 40^{\circ}$ C). Температура поверхности исследуемого образца составляла 80 К. Все образцы были получены из газовой фазы и представляли собой длинные пластинки, в плоскости которых находилась ось с [23].

В α"-модификации арсенида кадмия наблюдаются две интенсивные полосы отражения и ряд слабых особенностей (рис. 1). Первая полоса оказалась дублетнорасщепленной, причем особенно хорошо расщепление проявляется при низких температурах. Этот дублет аналогичен структуре E_1 , $E_1 + \Delta_1$ в InAs, которая объясняется переходами в точке L или на направлении Λ , а дублетность вызвана спин-орбитальным расщеплением верхней валентной зоны, состоящей из *p*-уровней атомов As, причем величина Δ_{s-o} составляет на направлении Λ две трети от величины Δ_{s-o} в точке Г. Положение максимумов компонентов дублета приведено в таблице для случая, изображенного на рис. 1. В других образцах положение максимумов может смещаться на 0.01 эВ в сторону больших или меньших энергий. В некоторых образцах наблюдалось другое соотношение интенсивностей компонентов дублета (примерно одинаковое). Вторая интенсивная полоса, аналогичная структуре Е2 в кристаллах А^{III}В^V, расположена вблизи 4 эВ. Коэффициент отражения в максимуме обеих полос достигает 40-43%. Между интенсивными полосами при 80 К проявляются две слабые ступеньки (рис. 1), которые в других образцах видны более отчетливо и могут смещаться по положению на 0.1-0.2 эВ. В некоторых образцах проявлялись очень слабые структуры (в виде перегибов) при энергиях примерно 1.6 и 4.3 эВ, а также широкая полоса при 1.3–1.4 эВ. Повышение температуры от 80 до 293 К мало изменяет внешний вид спектров. Слабые структуры не проявляются, дублетное расщепление выражено хуже. Средний температурный коэффициент смещения пиков составляет $-(1.5-3.0) \cdot 10^{-4}$ эВ/К. Следует отметить, что даже при 80 К анизотропия в спектрах отражения α'' -Cd₃As₂ не обнаруживается.

Главные особенности спектров отражения α' -Cd₃As₂ (рис. 2) такие же, как и в α'' -полиморфной модификации. Однако дублетность Е1 проявляется менее отчетливо, что может быть связано с меньшим совершенством исследованных образцов. Расщепление пиков дублета оказалось таким же, как и в α'' -модификации, однако наблюдался сдвиг по энергиям в длинноволновую область в обеих поляризациях (см. таблицу). В спектрах отражения отчетливо проявляется анизотропия. Если компоненты дублета отличаются по интенсивности (коротковолновая компонента более четко выражена в поляризации $\mathbf{E} \perp \mathbf{c}$), то полоса E_2 поляризована по положению максимума. Структура в области 2.5-2.7 эВ не обнаружена, однако проявляются довольно интенсивные поляризованные пики при $3.08 \Rightarrow B$ (**E** || **c**), $3.20 \Rightarrow B$ $(\mathbf{E} \perp \mathbf{c})$. Кроме того, имеется четкий пик при 1.60 эВ (только при $\mathbf{E} \perp \mathbf{c}$).

Из сопоставления полученных данных с известными ранее прежде всего следует отметить в последних сильный спад отражения в коротковолновой области. При этом может происходить смещение пика E_2 в



Рис. 2. Спектры отражения монокристалла α' -Cd₃As₂ при 80 К и поляризации света $\mathbf{E} \perp \mathbf{c}$ (1) и $\mathbf{E} \parallel \mathbf{c}$ (2).

Физика и техника полупроводников, 2005, том 39, вып. 3

Наши данные (отражение)				Данные по отражению других авторов					Термоотражение		Теоретические
α'' -кристаллы		lpha'-кристаллы-80 К		[16]		[17]		[20]	[18]	[19]	расчеты
293 K	80 K	E c	$\mathbf{E}\perp\mathbf{c}$	293 K	77 K	Моно.	Поли.	293 K	293 K	293 K	[8]
_	1.4	-	-	-	-	1.43	1.41	_	1.43	1.41	1.2
_	1.6	_	1.60	_	_	-	_	_	_	—	_
1.76	1.79	1.75	1.76	1.7	1.74	1.71	1.71	1.70	1.74	-	1.8
1.91	1.98	1.90	1.90	1.88	1.90	1.91	1.89	_	1.95	-	_
_	2.5	_	_	2.86	2.86	_	_	_	_	2.30	2.8
_	3.1	3.08	3.20	3.33	3.26	_	_	_	3.24	_	_
3.93	3.98	4.01	3.93	3.7	3.7	3.80	3.63	3.60	_	3.70	3.8
_	4.3	-	_	-	-	4.50	_	_	_	4.60	4.7
-	-	-	—	5.15	-	5.15	—	—	—	5.16	5.2

Энергетическое положение пиков отражения и термоотражения (в эВ) в кристаллах арсенида кадмия по данным разных авторов

длинноволновую область на 0.1 эВ. В области энергий hv > 3 эВ вследствие наложения крутого спада отражения на наблюдаемый в действительности его рост может возникнуть ложный пик. Вполне возможно, что пик при 3.33 эВ [16] обусловлен наличием на поверхности тонкой пленки, которая образуется в случае отклонения от оптимальных технологических режимов. Мы показали, что полировка таких образцов приводит к увеличению R в ближней ультрафиолетовой области на 10-20%. Пленка может возникать и при травлении поверхности образцов (в некоторых работах использовались полированные с последующим травлением образцы). Маловероятно, что наблюдаемый спад R объясняется только шероховатостью поверхности [24], хотя некоторый вклад она и дает. Характерно, что при понижении темппературы от 293 до 77 К в [16] пик при 3.33 эВ смещался в длинноволновую область, а пик при 3.7 эВ оставался на месте, — по-видимому, сказывалась дополнительная пленка масла, которое поступало из вакуумной системы. Таким образом, наблюдаемая разница в спектральном распределении коэффициента отражения арсенида кадмия, по данным разных авторов, связана с совершенством поверхности образцов. Этим же объясняется и большой разброс положения максимума самой коротковолновой полосы Е2 (см. таблицу). Чем хуже поверхность образца, тем сильнее сдвигается эта структура в длинноволновую область. Эту закономерность хорошо иллюстрируют данные в [17], где максимум E_2 на монокристаллах расположен при 3.80 эВ, а на поликристаллах — при 3.63 эВ. Из таблицы видно, что максимумы E_1 и $E_1 + \Delta_1$, по данным пяти авторов, хорошо совпадают (с учетом естественного разброса от образца к образцу, а также с возможностью изучения разных модификаций Cd₃As₂). В то же время пики между E_1 и E_2 сильно меняются по положению, интенсивности, характеру анизотропии. Не исключено, что здесь проявляются "плавающие особенности", которые связаны со степенью дальнего порядка в расположении вакансий катионных подрешеток [25].

По нашим данным, величина спин-орбитального расщепления составляет 0.15–0.19 эВ, что неплохо совпадает с теоретическими расчетами [26]. На основе наших прецизионных спектров отражения можно получить с помощью соотношений Крамерса–Кронига полный комплекс оптических функций арсенида кадмия [27,28], в том числе и мнимую часть диэлектрической проницаемости ε_2 , сравнение которой с теоретическими результатами может подтвердить правильность расчетов зонной структуры Cd₃As₂ для реальной структуры.

Список литературы

- [1] E.K. Arushanov. Prog. Cryst. Growth Charact., 3, 211 (1981).
- [2] В.Б. Лазарев, В.Я. Шевченко, Я.Х. Гринберг, В.В. Соболев. Полупроводниковые соединения группы А^{II}В^V (М., 1976).
- [3] В.В. Соболев. Энергетическая структура узкозонных полупроводников (Кишинев, 1983).
- [4] M. Stakelberg, P. Paulus. Z. Phys. Chem., 28 (2), 5427 (1935).
- [5] G.A. Steigman, J. Gooder. Acta Cryst. B, 24 (8), 1062 (1968).
- [6] A. Pietraszko, M. Lucaszevicz. Phys. St. Sol. A, 18 (2), 723 (1973).
- [7] А.Д. Изотов, В.П. Саныгин, В.Ф. Пономарев. Кристаллография, 23 (4), 764 (1978).
- [8] Н.В. Кудрявцева. Изв. вузов СССР. Физика, (11), 93 (1971).
- [9] P.J. Ling-Chung. Phys. Rev., 188 (3), 1272 (1969).
- [10] B. Dowgiallo-Plenkievicz, P. Plenkievicz. Phys. St. Sol. B, 94 (1), K57 (1979).
- [11] J. Bodnar. Proc. 3rd Int. Conf. Phys. Narrow-Gap Semicond. (Warsaw, 1978) p. 311.
- [12] I. Wagner, E.D. Palik, E.M. Swiggard. Phys. Chem. Sol. Suppl. (1), 471 (1971).
- [13] M.J. Aubin, L.G. Caron, J.P. Jay-Gerin. Phys. Rev. B, 15 (8), 3872 (1977).
- [14] A.I. Belogorokhov, I.S. Zakharov, A.V. Kochura, A.F. Knjazev. Appl. Phys. Lett. 77 (14), 1 (2000).
- [15] В.В. Соболев, Н.Н. Сырбу. Изв. АН СССР. Неорг. матер., 2 (6), 1011 (1966).
- [16] В.В. Соболев, Н.Н. Сырбу, Т.А. Зюбина, Я.А. Угай. ФТП, 5 (2), 327 (1971).

- [17] K. Karnicka-Moscicka, A. Kisiel, L. Zdanowicz. Sol. St. Commun., 44 (3), 373 (1982).
- [18] M.J. Aubin, J.P. Cloutier. Canadien J. Phys., 53 (17), K42 (1975).
- [19] V.P. Bhola. Phys. Status Solidi A, 34 (2), K179 (1976).
- [20] M. Zivitz, J.R. Stevenson. Phys. Rev. B, 10 (6), 2457 (1974).
- [21] A.I. Kozlov, S.G. Kozlova, A.F. Knjazev. Moldavian J. Phys. Sci., 2 (2), 160 (2003).
- [22] В.В. Соболев, В.В. Немошкаленко. Методы вычислительной физики в теории твердого тела. Электронная структура полупроводников (Киев, 1988).
- [23] Э.К. Арушанов, А.Ф. Князев, Л.С. Коваль. Тез. конф. "Тройные полупроводники и их применение", Кишинев (1983) с. 165.
- [24] K. Karnicka-Moscicka, A. Kisiel. Surf. Sci., 121, L545 (1982).
- [25] Г.П. Чуйко, Н.М. Чуйко. ФТП, 17 (6), 1145 (1983).
- [26] B. Dowgiallo-Plenkievicz, P. Plenkievicz. Phys. St. Sol. B, 87 (1), 309 (1978).
- [27] A.I. Kozlov. Proc. Int. Conf. on Material Science and Condensed Matter Physics, Chisinau (2001) p. 42.
- [28] A.I. Kozlov, V.E. Grachev, V.V. Sobolev. Proc. 5th General Conf. Balkan Physical Union, (Vrnjaeka Banja, 2003), p. 719.

Редактор Л.В. Беляков

Reflection spectra of two cadmium arsenide polymorphic modifications

A.I. Kozlov, V.V. Sobolev*, A.F. Knjazev+

International Laboratory of Superconductivity and Solid State Electronics, Academy of Sciences, MD2028 Kishinev, Moldova * Udmurt State University, 426034 Izhevsk, Russia + State University, 305000 Kursk, Russia

Abstract Presented are new results on investigations of optical properties of cadmium arsenide. Most correct reflection spectra have been obtained on perfect crystals and up-to-date spectral equipment. The reflectivity of a polymorphic α'' -Cd₃As₂ (space group D_{4h}^{15}) and α' -Cd₃As₂ (space group D_{4h}^{11}) is measured at the room and that of liquid nitrogen temperatures within the range 1-5 eV by a polarized light ($\mathbf{E} \perp \mathbf{c}, \mathbf{E} \parallel \mathbf{c}$). For the first time the anisotropy of spectra obtained was detected in case of α' -modification. In this work, we have compared results for both modifications with experimental and theoretical data of other authors.